

晶圆清洗设备 SWC-4000兆声晶圆（掩模版）清洗机

产品名称	晶圆清洗设备 SWC-4000兆声晶圆（掩模版）清洗机
公司名称	上海耀他科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那诺-马斯特 型号:SWC-4000 产地:美国
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号6幢101室JT4 602（注册地址）
联系电话	021-62318025 17317363700

产品详情

SWC-4000兆声晶圆（掩模版）清洗机概述：兆声和清洗技术的发展，对MEMS和半导体等领域的晶圆和掩模版清洗提供了的水平，可以帮助用户获得干净的晶圆片和掩模版。

NANO-MASTER提供兆声单晶圆&掩模清洗(SWC)系统，用于先进的无损兆声清洗。可以适用于易受损的带图案或无图案的基片，包含带保护膜的掩模版。为了确保不损伤基片的情况下达到优化的清洗效果，兆声能量的密度必须保持在稍稍低于样片上任意位置上的损伤阈值。NANO-MASTER的技术确保了声波能量均匀分布到整个基片表面，通过分布能量的z大化支持z理想的清洗，同时保证在样片的损伤阈值范围内。

SWC系统提供了可控的化学试剂滴胶能力，这使得颗粒从基片表面的去除能力得以进一步加强。SWC和LSC具备对点试剂滴胶系统，可以*节省化学试剂的用量的。滴胶系统支持可编程的化学试剂混合能力，提供了可控的化学试剂在整个基片上的分布。

通过联合使用化学试剂滴胶和NANO-MASTER的兆声清洗技术，系统去除颗粒的能力得到进一步优化。颗粒从表面被释放的能力也因此得到提升，从而被释放的颗粒在幅流的DI水作用下被扫除出去，而把回附的数量降到了z低水平。从基片表面被去除。如果没有使用幅流DI水的优势，先进的静态可循环兆声清洗槽会有更大数量的颗粒回附，并且因此需要更多的去除这些颗粒。

此外，NANO-MASTER的清洗机都还提供了一系列的选配功能。PVA软毛刷提供了机械的方式去除无图案基片上的污点和残胶。DI水臭氧化的选配项提供了有机物的去除，而无须腐蚀性的化学试剂。我们的氢化DI水系统跟兆声能量结合可以达到纳米级的颗粒去除。根据不同的应用，某些选配项将会进一步提高设备去除不想要的颗粒和残留物的能力。

SWC系统能够就地实现热氮或异丙醇甩干。“干进干出”一步工艺可以在我们的系统中以最低的投资和购置成本来实现。NANO-MASTER清洗机的工艺处理时间可以在3-5分钟内完成，具体是3分钟还是5分钟取决于基片的尺寸以及附加的清洗配件的使用情况。

NANO-MASTER的技术也适用于清洗背部以及带保护膜掩模版前面的对准标记，降低这些掩模版的不必要去除和重做保护膜的几率。它也可以用于去除薄膜胶黏剂的黏附性并准备表面以便再次覆膜。此外，带薄膜掩模版的全部正面的兆声清洗以及旋转甩干可以做到无损并且对薄膜无渗漏。

SWC是一款带有小占地面积的理想设备，并且很容易安装在空间有限的超净间中。该系列设备都具有出众的清洗能力，并可用于非常广泛的基片。

SWC-4000兆声晶圆（掩模版）清洗机应用：

湿法刻蚀

带图案或不带图案的掩模版和晶圆片

Ge, GaAs以及InP晶圆片清洗

CMP处理后的晶圆片清洗

晶圆框架上的切粒芯片清洗

等离子刻蚀或光刻胶剥离后的清洗

带保护膜的分划版清洗

掩模版空白部位或接触部位清洗

X射线及极紫外掩模版清洗

光学镜头清洗

ITO涂覆的显示面板清洗

兆声辅助的剥离工艺

特点：

支持12”直径的圆片或9”x9”方片

独立系统

无损兆声,试剂，毛刷清洗及旋转甩干

微处理机自动控制

化学试剂滴胶单元

溶剂与酸分离排废

热氮

30 " D x 26 " W 的占地面积

选配项：

机械手自动上下载片

掩模板或晶圆片夹具

臭氧清洗

PVA软毛刷清洗

高压DI清洗

氮气离子发生器

我公司主要经营各类真空镀膜微纳加工设备，包括薄膜沉积、刻蚀及清洗去胶设备等（ALD，PECVD，RIE，磁控溅射，热蒸镀，电子束，离子束，热真空试验，晶圆清洗机，PA-MOCVD）